

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

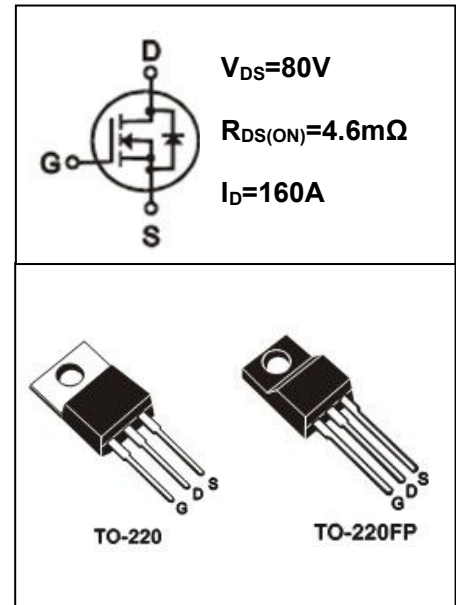
SIF160N080

- 特点：热阻低 导通电阻低 栅极电荷低，开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
- FEATURES: ■LOW THERMAL RESISTANCE ■LOW $R_{DS(ON)}$ TO MINIMIZE CONDUCTIVE LOSS ■LOW GATE CHARGE FOR FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT
- 应用：低压高频逆变电路 同步整流 开关应用
- APPLICATION: ■LOW VOLTAGE,HIGH FREQUENCY INVERTERS ■SYNCHRONOUS RECTIFICATION ■SWITCH APPLICATIONS

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-220/220FP

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V_{DS}	80	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V_{GS}	± 20	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C ①	I_D	160*	A
耗散功率 Total Power Dissipation ①	P_{tot}	210 FP:42	W
最高结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T_{STG}	-55-175	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E_{AS}	1000	mJ



●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	80	95		V
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$ ③	2	3	4	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I_{DSS}	$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V$			1	μA
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS}=0$)	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$			±100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=50A$ ③		4.6	5.5	mΩ
跨导 Forwad Transconductance	g_{FS}	$V_{DS}=5V, I_D=50A$ ③		84.2		S

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220(FP) 条管装/TUBE PACKING	SIF160N080 TO-220(FP)-TU	SIF160N080 TO-220(FP)-TU-HF

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF160N080

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
输入电容 Input Capacitance	Ciss	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 40V$ $F = 1.0MHz$		3086		pF
输出电容 Output Capacitance	Coss			1057		
反向传输电容 Reverse Transfer Capacitance	Crss			26		
导通延迟 Turn -On Delay Time	Td(on)	$V_{DD}=40V, R_L=3\Omega$ $V_{GS} = 10V$		20.1		ns
开启上升时间 Turn -On Rise Time	T_r			38.9		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	Td(off)			45.1		
关断下降时间 Turn -Off Fall Time	T_f			22.8		
栅极电荷 Total Gate Charge	Qg	$I_D = 50A, V_{DS} = 40V$ $V_{GS} = 10V$		55		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Qgs			15		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Qgd			13		nC
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j=25^\circ C, I_s=50A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.35	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	$T_j=25^\circ C, I_s=20A$ $di/dt=500A/\mu s$ ③		60		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Qrr			560		nC

●热特性

● Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX		单位 UNIT
		TO-220	TO-220FP	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	RthJC	0.89	3.13	°C/W
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	RthJA	62.5	62.5	°C/W

注释(Notes):

- ① 以最高结温为限制，基于 TO-220 封装形式，25°C 下本产品硅限电流 I_D 为 160A。
 I_D & P_D base on maximum allowable junction temperature, calculated upon TO-220 package type is limited to carry 160A at 25°C.
- ② 初始结温=25°C, $V_{DD} = 40V, V_G = 10V, L = 1mH, R_G = 25\Omega$ 。
Starting $T_j = 25^\circ C, V_{DD} = 40V, V_G = 10V, L = 1mH, R_G = 25\Omega$.
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s, Duty\ cycle \leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF160N080

● 特性曲线

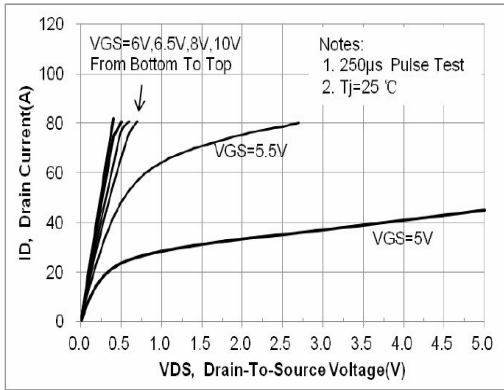


图 1 输出特性曲线, $T_c=25^\circ\text{C}$

Fig1 Typical Output Characteristics, ($T_c=25^\circ\text{C}$ Temperature)

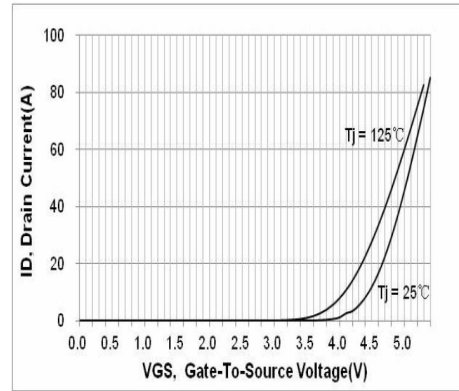


图 2 传输特性曲线

Fig2 Transfer Characteristics(Junction

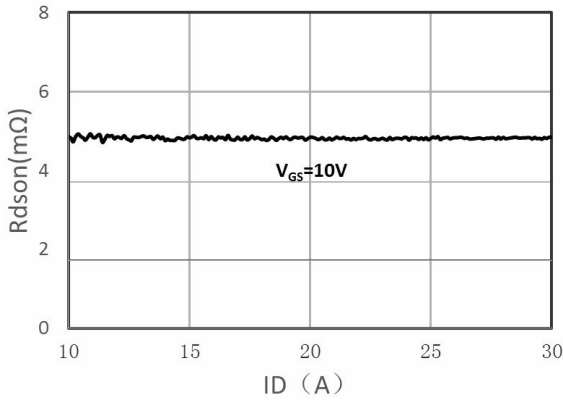


图 3 导通电阻与漏极电流 \VGS 曲线

Fig3 On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

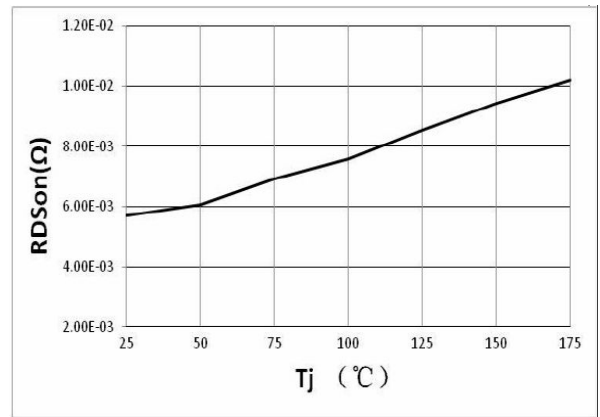


图 4 导通电阻与结温度曲线

Figure 4. On-Resistance vs. Junction Temperature

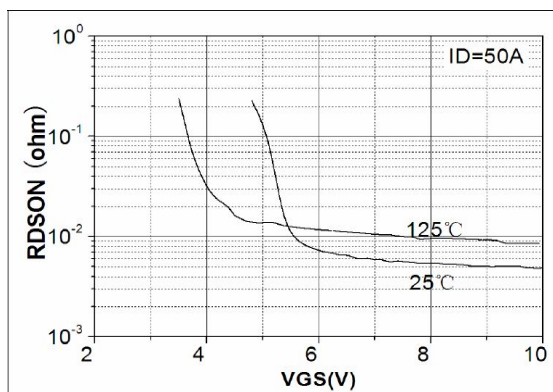


图 5 导通电阻与栅源电压、结温曲线

Fig5 Typical Gate Charge V.S Gate-to-Source Voltage

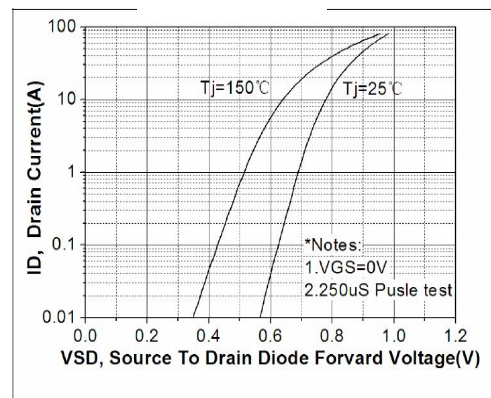


图 6.体二极管特性曲线

Fig6 Body-Diode

Characteristics

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF160N080

● 特性曲线

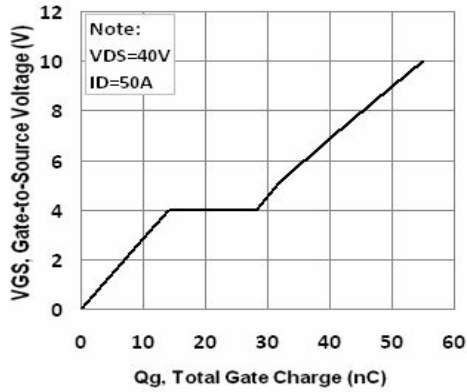


图 7 栅电荷特性曲线

Figure 7. Gate-Charge Characteristics

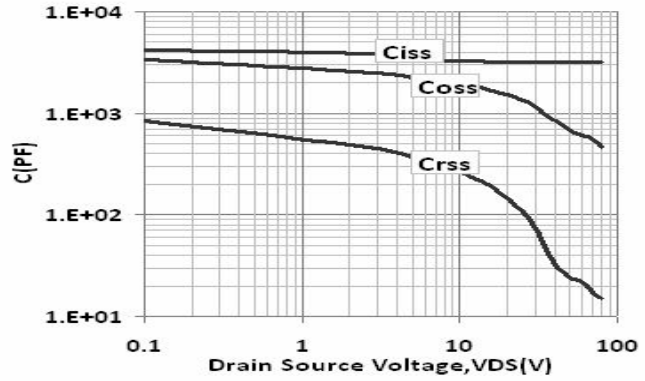


图 8 电容特性曲线

Figure 8. Capacitance

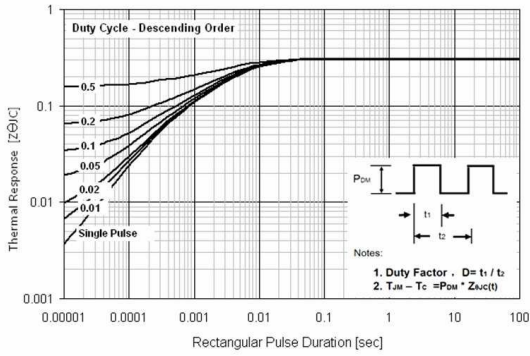


图 9 标准化热阻曲线 (RthjC)

Fig9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (RthJC)

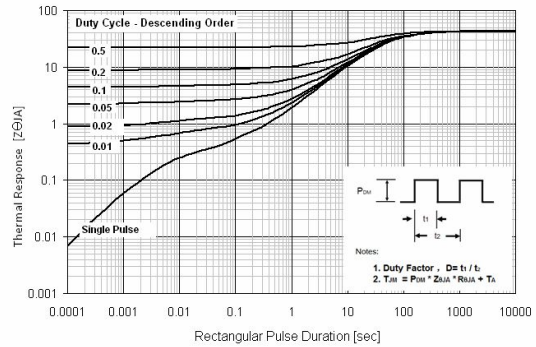


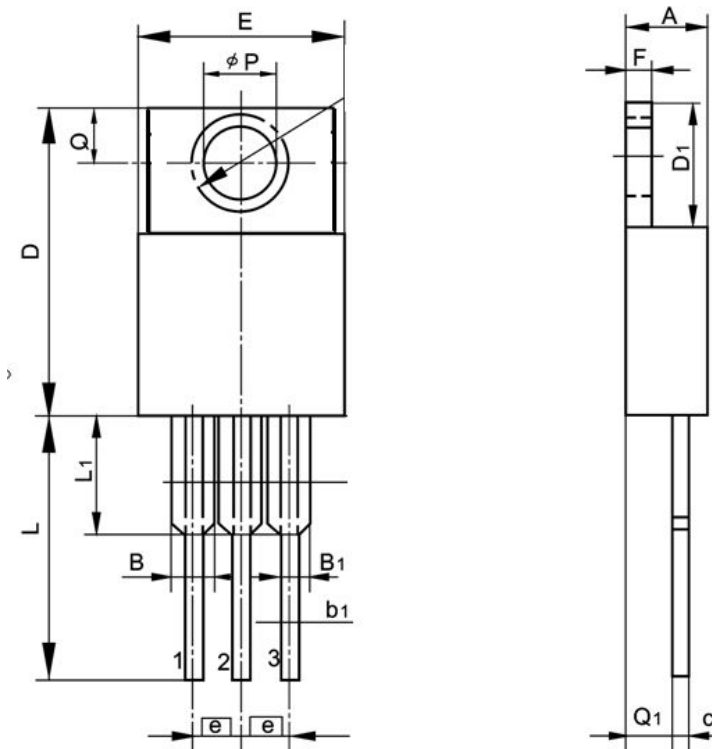
图 10 标准化热阻曲线 (RthjA)

Figure 10. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (RthJA)

TO-220 封装机械尺寸 TO-220 MECHANICAL DATA

单位：毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.00		4.80	E	9.90		10.70
B	1.20		1.50	e		2.54	
B1	1.00		1.40	F	1.10		1.45
b1	0.65		1.00	L	12.50		14.50
c	0.35		0.75	L1	3.00	3.50	4.00
D	15.00		16.50	Q	2.50		3.00
D1	5.90		6.90	Q1	2.00		3.00
				ϕP	3.60		3.90



TO-220FP 封装机械尺寸 TO-220FP MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	E	9.60		10.30
A ₁	2.30		2.90	e		2.54	
b	0.70		0.90	L	12.40		14.00
b ₁	1.18		1.45	L₂	2.30		2.60
c	0.40		0.70	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	øp	3.00		3.50
D1	6.10		9.00	Q	2.30		2.80

